

УДК 533.951

А. Н. Васильев

ТЕОРИЯ АНОМАЛЬНОГО СКИН-ЭФФЕКТА В ПЛАЗМЕННОМ ШНУРЕ СО СТЕПЕННЫМ СПАДАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

Введение. В предлагаемой работе рассмотрена задача об аномальном скин-эффекте в плазменном цилиндре со степенной зависимостью концентрации электронов от радиуса. В предыдущих работах, посвященных аномальному скин-эффекту в плазменном шнуре [1—3], рассматривался гауссов профиль концентрации электронов, который в ряде случаев не адекватен экспериментальной ситуации при сильном скин-эффекте. В связи с этим интересно рассмотреть аналогичную задачу при значительно более медленном спадании концентрации электронов.

В статье используется цилиндрическая система координат (r, φ, z) , в которой ось z совпадает с осью плазменного шнура, симметричного относительно этой оси и однородного по z .

Целью данной работы является получение характеристик плазмы — коэффициента отражения электромагнитной волны от шнура и погонного сопротивления плазмы. Возбуждающая волна предполагается цилиндрической, не зависящей от азимутального угла φ и может быть электрического ($E_z \neq 0, H_z = 0$) или магнитного ($E_z = 0, H_z \neq 0$) типа [4]. Эти два случая необходимо рассмотреть отдельно (см. § 2, 3). В § 1 рассмотрены некоторые общие вопросы вывода исходных уравнений. Окончательные ответы найдены для случая, когда скин-эффект сильный, то есть электромагнитная волна затухает, не дойдя до областей, в которых зависимость электронной концентрации от радиуса начинает отклоняться от степенного закона. Длина пробега предполагается много больше характерной глубины проникновения электромагнитного поля в плазму. Это позволяет решать задачу в приближении эффективной частоты соударений $\nu_{\text{эфф}}$.

§ 1. Исходные уравнения. Предположим, что распределение электронов в плазменном шнуре в отсутствие электромагнитной волны является равновесным и определяется формулой Больцмана

$$n_e(r) = n_0 \exp \{ -U_e(r)/T_e \},$$

где $U_e(r)$ — потенциал сил, действующих на электроны, T_e — их температура. Функция $U_e(r)$ монотонно возрастает с ростом радиуса r .

В присутствии цилиндрической электромагнитной волны $e^{-i\omega t} \mathbf{E}(r)$ плазменный шнур описывается уравнениями Максвелла и кинетическим уравнением для функции распределения электронов. Амплитуда падающей волны предполагается малой, поэтому линеаризуем кинетическое

уравнение. Для добавки $e^{-i\omega t} f(r, \mathbf{p})$ к равновесной функции распределения

$$f_0(r, \mathbf{p}) = (2\pi m T_e)^{-3/2} n_e(r) \exp(-p^2/2mT_e),$$

являющейся функцией только от полной энергии частицы $\varepsilon = U_e(r) + p^2/2m$, получим кинетическое уравнение, которое запишем в цилиндрической системе координат [5]:

$$\left[-i\omega + v_{\text{эфф}} + v_r \frac{\partial}{\partial r} + \left(\frac{p_\varphi v_\varphi}{r} - \frac{dU_e(r)}{dr} \right) \frac{\partial}{\partial p_r} - \frac{p_r v_\varphi}{r} \frac{\partial}{\partial p_\varphi} \right] f(r, \mathbf{p}) = eT_e^{-1} \mathbf{E}(r) \mathbf{v} f_0 \equiv \zeta(r, \mathbf{p}). \quad (1)$$

Здесь \mathbf{v} и \mathbf{p} — скорость электрона и его импульс, $e = -|e|$ — заряд электрона. Характеристики этого уравнения совпадают с интегралами движения частицы: импульсом вдоль оси z $p_z = \text{const}$, моментом количества движения по оси z $M = r p_\varphi = \text{const}$ и энергией поперечного движения $E = m v_r^2/2 + U_e(r) + M^2/2mr^2 = \text{const}$.

Граничные условия и метод решения этого уравнения аналогичны использованному в работе [6]. Решения уравнения (1) удобно записать, предварительно введя функции различной четности по p_r :

$$f^{(+)} = [f(p_r > 0) + f(p_r < 0)]/2, \quad f^{(-)} = i[f(p_r > 0) - f(p_r < 0)]/2,$$

и аналогично для $\zeta^{(\pm)}$, которые могут быть записаны (см. (1)) в виде

$$\begin{aligned} \zeta^{(+)} &= e f_0(\varepsilon) (m T_e)^{-1} [p_z E_z(r) + M E_\varphi(r)/r], \\ \zeta^{(-)} &= i e f_0(\varepsilon) T_e^{-1} v_r(r) E_r(r). \end{aligned} \quad (2)$$

Здесь $v_r(r) = \sqrt{2(E - U_e(r) - M^2/2mr^2)/m}$, причем берется положительное значение квадратного корня. Введение этих двух функций необходимо из-за двужначности преобразования $E, M, p_z \rightarrow p_r, p_\varphi, p_z$. Радиальный ток выражается через интеграл по E, M, p_z от $f^{(-)}$, а j_φ и j_z — от $f^{(+)}$. Решение (1) имеет в этих обозначениях вид:

$$\begin{pmatrix} f^{(+)}(r) \\ f^{(-)}(r) \end{pmatrix} = \frac{i}{\sin B(r_2^*, r_1^*)} \int_{r_1^*}^{r_2^*} \frac{dr'}{v_r(r')} \hat{D}(r, r') \begin{pmatrix} \zeta^{(+)}(r') \\ \zeta^{(-)}(r') \end{pmatrix}, \quad (3)$$

где матрица $\hat{D}(r, r')$ определяется следующим образом:

$$\hat{D}(r, r') = \begin{pmatrix} \cos B(r_2^*, r) \cos B(r', r_1^*) & -\cos B(r_2^*, r) \sin B(r', r_1^*) \\ \sin B(r_2^*, r) \cos B(r', r_1^*) & -\sin B(r_2^*, r) \sin B(r', r_1^*) \end{pmatrix}, \quad r > r'; \quad (4)$$

$$\hat{D}(r, r') = \hat{D}(r', r) \quad \text{при } r < r'.$$

Здесь r_1^*, r_2^* — решения уравнения $v_r(r^*) = 0$ — классические точки поворота, $B(r, r') = \omega^* t(r, r')$, где $\omega^* = \omega + i v_{\text{эфф}}$, а $t(r, r') = \int_{r'}^r \frac{dr'}{v_r(r')}$ — время пролета частицы от радиуса r' до r .

Упростим теперь выражения для тока в плазме в случае предельно аномального скин-эффекта

$$\omega^* \tau(E, M) \ll 1, \quad (5)$$

где $\tau(E, M) = t(r_2^*, r_1^*) = \frac{1}{2} \oint dr/v_r(r)$ — половина периода движения частицы по радиусу. В этом случае синусами в (4) можно пренебречь, косинусы с большой точностью равны 1, и поэтому $f^{(+)} \gg f^{(-)}$. В дальнейшем оставляем только члены, содержащие $f^{(+)}$. Отсюда следует, что j_r мал по сравнению с j_φ и j_z и соответственно E_r мало по сравнению с E_φ и E_z . В этом пределе получим

$$f^{(+)} = \frac{ief_0(\epsilon)}{mT_e \omega^* \tau(E, M)} \int_{r_1^*}^{r_2^*} \frac{dr'}{v_r(r')} [p_z E_z(r') + ME_\varphi(r')/r']. \quad (6)$$

Отметим, что с точностью до малого параметра (5) $f^{(+)}$ не зависит от r , а является функцией E, M, p_z , то есть определяется не конкретным положением электрона на траектории, а всем предшествующим движением частицы по данной траектории.

Запишем, наконец, выражение для тока в плазме. Из-за нечетности первого члена в (6) по p_z , а второго по M , ток j_z зависит только от E_z , а j_φ — от E_φ :

$$j_z(r) = \frac{2ie^2}{\omega^* T_e m^2} \iiint \frac{dp_z dE dM}{rv_r(r)} \frac{p_z^2 f_0(\epsilon)}{\tau(E, M)} \int_{r_1^*}^{r_2^*} \frac{dr'}{v_r(r')} E_z(r'). \quad (7)$$

Аналогичное соотношение можно записать и для j_φ . Подставляя (7) в уравнения Максвелла, видим, что система уравнений в случае сильного скин-эффекта распадается на уравнения только для E_z и только для E_φ . По этой причине волны электрического и магнитного типов можно рассматривать отдельно друг от друга.

§ 2. Взаимодействие плазменного шнура с волной электрического типа ($H_z = 0$). Произведем в выражении для j_z (7) смену порядка интегрирования, переносим интегрирование по r' на первое место. Интегрирование по p_z проводится тривиально, после чего получаем следующее интегродифференциальное уравнение для $E_z(r)$:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{d}{dr} E_z(r) = \int_0^\infty r' dr' G_z(r, r') E_z(r'), \quad (8)$$

в котором ядро $G_z(r, r')$ можно записать в виде

$$G_z(r, r') = \frac{2}{\pi} \frac{\omega_0^2}{rr'c^2 \omega^* m T_e} \int_{E_{\min}}^\infty dE \int_0^{M^*} dM \frac{\exp(-E/T_e)}{\tau(E, M) v_r(r) v_r(r')}. \quad (9)$$

Здесь $\omega_0^2 = 4\pi e^2 n_0/m$, n_0 — плотность электронов в точке $U_e(r) = 0$, $E_{\min} = \max\{U_e(r), r \rightarrow r'\}$, $M^* = \min\{\sqrt{2mr^2(E - U_e(r))}, r \rightarrow r'\}$.

В уравнении (8) мы пренебрегли членом, пропорциональным току смещения, что приводит к необходимости сшивать решение уравнения (8) с решением в свободном пространстве, представляющим из себя суперпозицию функций Ганкеля

$$E_z(r) \xrightarrow{r \gg a} E_{z0} [H_0^{(2)}(\omega r/c) + R_z H_0^{(1)}(\omega r/c)]. \quad (10)$$

В этой формуле a — размер пучка, R_z — коэффициент отражения электромагнитной волны. Чтобы решение уравнения (8) переходило в (10), оно должно иметь асимптотику вида

$$E_z(r) \approx a(\ln r/a - \beta), \quad (11)$$

где параметр β связан с коэффициентом отражения R_z (см. также [1]):

$$R_z = \frac{\beta + \ln \omega a/2c + C + i\pi/2}{\beta + \ln \omega a/2c + C - i\pi/2}, \quad C = 0,577 \dots \quad (12)$$

и погонным сопротивлением единицы длины плазменного шнура

$$\rho_z = -2\omega c^{-2} \operatorname{Im} \beta. \quad (13)$$

Формулы (8, 9) определяют уравнения для волн в плазме при произвольной зависимости U_e от радиуса, например, квадратичной (подробно см. [1—3]). В [1] указывается, что в случае сильного скин-эффекта уравнения (8), (9) переходят в уравнения для плоского слоя плазмы [7]. Этот вывод основан на пренебрежении членом с центробежной энергией в выражении для $v_r(r)$. Однако такой вывод верен только в случае быстрого изменения концентрации электронов с расстоянием от оси. В случае же степенного спада концентрации электронов изменение центробежной энергии и изменение $U_e(r)$ при движении электрона имеют одинаковый порядок величины, что приводит к необходимости учета всех возможных значений момента M . Поэтому в дальнейшем мы будем изучать случай именно степенного спада концентрации электронов

$$n_e(r) = n_0(r/a)^{-K}, \text{ то есть } U_e(r) = KT_e \ln(r/a).$$

При этом для заданного E максимальное значение, которое может принимать M , экспоненциально растет с ростом энергии [8]:

$$M_{\max} = a \sqrt{m T_e K} \exp(E/KT_e - 1/2).$$

Перейдем от переменных r и M к переменным $\mu = M/M_{\max}$,

$$x = (r/a)^2 \exp(-2E/KT_e) = \exp[-2(E - U_e(r))/KT_e].$$

В этих переменных полупериод движения запишется в виде

$$\tau(E, M) = \frac{a}{2} \sqrt{\frac{m}{KT_e}} \sigma(\mu) \exp(E/KT_e + 1/2), \quad (14)$$

где $\sigma(\mu) = \int_{x_1}^{x_2} dx (ex \ln 1/x - \mu^2)^{-1/2}$ — функция, зависящая только от безразмерного параметра μ , x_1 и x_2 — корни уравнения $ex \ln 1/x = \mu^2$. Из

выражения (14) видно, что период движения зависит от E экспоненциально, или, что то же самое, линейно растет с ростом масштабов траектории. Траектории движения с одинаковым значением μ подобны, что и позволяет довести решение задачи до конца. При движении по траектории параметр x изменяется от x_1 до x_2 .

Сделаем указанную замену переменных в выражении (9) и заменим интегрирование по E интегрированием по x . Тогда (9) переписывается в виде

$$G_z(r, r') = a^{-4} g(\omega) \begin{cases} (a/r)^{2+K} \cdot P_z(r/r'), & r > r', \\ (a/r')^{2+K} \cdot P_z(r'/r), & r < r', \end{cases} \quad (15)$$

где $g(\omega) = a^2 \omega \omega_0^2 / c^2 \omega^*$,

$$P_z(\zeta) = \frac{2K}{\pi} \int_0^1 x^{K/2} dx \int_0^{\mu(x, \zeta)} \frac{d\mu}{\sigma(\mu)(ex \ln 1/x - \mu^2)^{1/2} (ex \zeta^{-2} \ln \zeta^2/x - \mu^2)^{1/2}},$$

$$\mu(x, \zeta) = \min \{ \sqrt{ex \ln 1/x}, \sqrt{ex \zeta^{-2} \ln \zeta^2 x^{-1}} \}.$$

Как видно из формулы (15), ядро интегрального уравнения может быть представлено произведением степени r на функцию только от r/r' , поэтому полезно применить к этому уравнению преобразование Меллина

$$F_z(q) = \int_0^\infty E_z(r) \frac{r^{q-1} dr}{a^q}, \quad E_z(r) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-l\infty}^{c+l\infty} F_z(q) (r/a)^{-q} dq, \quad (16)$$

в результате чего получим функциональное уравнение для функции $F_z(q)$ (более подробно аналогичные преобразования интегриродифференциальных уравнений проведены в [6, 7, 9]):

$$(q + K - 2)^2 F_z(q + K - 2) = g(\omega) S_z(q) F_z(q). \quad (17)$$

В этом уравнении $S_z(q)$ выражается через новую функцию двух переменных

$$\rho(\mu, q) = \int_{x_1}^{x_2} \frac{x^{-q/2} dx}{\sqrt{ex \ln 1/x - \mu^2}} \quad (18)$$

с помощью интегрального соотношения

$$S_z(q) = \frac{K}{\pi} \int_0^1 d\mu \rho(\mu, q) \rho(\mu, 2 - K - q) / \rho(\mu, 0). \quad (19)$$

Функция $\rho(\mu, q)$ существует при всех $0 \leq \mu \leq 1$ в полуплоскости $\operatorname{Re} q < 1$, поэтому $S_z(q)$ аналитично по крайней мере в полосе $1 - K < \operatorname{Re} q < 1$. Для малых $\mu^2 \ll 1$ и для $|1 - q| \gg 1/\ln e/\mu^2$ имеет место асимптотика

$$\rho(\mu, q) = [2\pi/e(-q + 1)]^{1/2} \exp[-\mu^2(1 - q)/2e].$$

В случае $K \gg 1$ подынтегральное выражение существенно отлично от нуля именно при этих значениях параметров μ и q , что приводит к следующему результату:

$$S_z(q) = K^{1/2} [(1-q)(K+q-1)]^{-1/2}, \quad |1-q| \gg 1, \quad |K+q-1| \gg 1. \quad (20)$$

Дополнительными условиями к уравнению (17) являются аналитичность решения в некоторой полосе и наличие полюса второго порядка (последнее следует из асимптотики (11)):

$$F_z(q) \approx \alpha(q^{-2} + \beta q^{-1} + \dots), \quad q \rightarrow 0.$$

Эти условия однозначно определяют решение уравнения (17).

Пусть $n=K-2$. Тогда решение уравнения (17) можно записать в виде

$$F_z(q) = n^{-2} \Gamma^2(-q/n) (g(\omega)/n^2)^{q/n} \varphi(q/n), \quad (21)$$

где $\varphi(x)$ удовлетворяет условиям

$$\varphi(x+1) = S_z(nx) \varphi(x), \quad \varphi(0) = 1. \quad (22)$$

Уравнение (22) подробно изучалось в [9], где получен аналитический вид решения (22) при произвольном виде ядра $S_z(q)$. Постоянная α в (21) в силу линейности уравнений положена равной 1. В случае больших $K \gg 1$ можно подставить асимптотику (20) в уравнение (22), которое можно решить непосредственно:

$$\varphi(x) = n^{-x/2} [\Gamma(1+1/n-x)/\Gamma(1+1/n+x)]^{-1/2}. \quad (23)$$

Вычисляя вычет функции $F_z(q)$ в полюсе $q=0$, находим [9]:

$$\beta = \frac{2C}{n} + \frac{1}{n} \ln g(\omega)/n^2 + \frac{\pi}{2n} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\ln S_z(i\omega n - n/2) d\omega}{\text{ch}^2 \pi \omega}. \quad (24)$$

В случае $K \gg 1$ можно использовать непосредственно решение (23):

$$\beta = \frac{3C}{n} - \frac{\pi^2}{6n} + \frac{1}{n} \ln g(\omega)/n^{5/2}. \quad (25)$$

Подставляя (24) и (25) в (12), находим коэффициент отражения электромагнитных волн электрического типа от плазмы.

Исследуем теперь погонное сопротивление плазмы, для чего необходимо найти мнимую часть (24). В интегральный член в выражении (24) входит $S_z(i\omega n - n/2)$; используя (19), имеем

$$S_z(i\omega n - n/2) = K\pi^{-1} \int_0^1 d\mu |\rho(\mu, i\omega n - n/2)|^2 / \rho(\mu, 0)$$

действительное положительное выражение. Поэтому погонное сопротивление плазмы связано только с аргументом $g(\omega)$:

$$\rho_z = 2\omega c^{-2} (K-2)^{-1} \arctg v_{\text{эф}}/\omega. \quad (26)$$

Как видно из (26), все сопротивление плазмы определяется только столкновениями частиц в плазме, а бесстолкновительного затухания типа затухания Ландау нет, поскольку частицы в среднем не движутся внутрь плазмы, а совершают лишь колебательные движения по ра-

диусу. При приближении K к 2 погонное сопротивление резко возрастает, что связано с расходимостью полного числа частиц в плазме на больших расстояниях при $K=2$. По этой же причине данным методом нельзя рассматривать концентрацию электронов, спадающую медленнее, чем $(r/a)^{-2}$.

Зная мнимую часть коэффициента отражения, легко оценить и глубину, на которую распространяется волна в плазму, и отсюда получить границы применимости вышензложенной теории. Эта процедура аналогична плоскому случаю [10]. Как видно из (11) эффективная точка отражения электромагнитной волны определяется равенством $r_0 \sim a \exp(\operatorname{Re} \beta)$, откуда для случая больших $K \gg 1$ получаем, что волна доходит до расстояний

$$r_0 \sim a \left[\frac{\omega_0^2 \omega a^2}{K^{5/2} c^2 |\omega^*|} \right]^{1/(K-2)},$$

что соответствует концентрациям частиц в области, в которой начинается поглощение, порядка

$$n(r_0) = (n_0 a^K)^{-2/(K-2)} \left[K^{5/2} \frac{|\omega^*|}{\omega} \frac{mc^2}{4\pi e^2} \right]^{K/(K-2)}. \quad (27)$$

Данная теория применима в случае, если зависимость концентрации частиц от расстояния начинает отличаться от степенной при плотностях, превышающих плотность, определяемую (27). Отметим, что в действительную часть β не входит тепловая скорость частиц и поэтому скин-эффект имеет много черт обычного скин-эффекта, а не аномального, несмотря на нелокальную с большим радиусом нелокальности связь тока с полем. Это произошло из-за того, что электроны многократно взаимодействуют с полем за период поля.

§ 3. Взаимодействие плазменного шнура с волной магнитного типа ($E_z=0$). Производя с уравнением для E_φ преобразования, аналогичные проведенным в предыдущем параграфе, получим функциональное уравнение для преобразования Меллина

$$((q+n)^2 - 1) F_\varphi(q+n) = g(\omega) S_\varphi(q) F_\varphi(q), \quad n = K - 2. \quad (28)$$

Здесь

$$S_\varphi(q) = \frac{K^2}{\pi e} \int_0^1 \mu^2 d\mu \rho(\mu, q+1) \rho(\mu, 3-K-q) / \rho(\mu, 0), \quad (29)$$

$g(\omega)$ и $\rho(\mu, q)$ определены в (15) и (18). S_φ аналитично в полосе $2-K < \operatorname{Re} q < 0$, а в случае больших $K \gg 1$ имеем

$$S_\varphi(q) = K^{1/2} [q(2-K-q)]^{-1/2} \approx S_z(q), \quad |q| \gg 1, \quad |2-K-q| \gg 1. \quad (30)$$

Некоторые особенности имеет процесс сшивки решения уравнения (28) со свободным решением $E_\varphi(r) = E_{\varphi 0} [H_1^{(2)}(\omega r/c) + R_\varphi H_1^{(1)}(\omega r/c)]$. Асимптотика этого решения имеет вид

$$E_\varphi(r) = -\alpha \frac{r}{a} (1 + \gamma a^2/r^2 + \dots), \quad (31)$$

что соответствует особенностям в преобразовании Меллина вида

$$F_{\varphi}(q) = \alpha[(q+1)^{-1} + \gamma(q-1)^{-1} + \dots].$$

Коэффициент отражения электромагнитной волны от плазменного шнура с логарифмической точностью запишется в виде

$$R_{\varphi} = \{2 + \gamma[\ln \omega a/2c + i\pi/2] \cdot a^2 \omega^2/c^2\} / \{2 + \gamma[\ln \omega a/2c - i\pi/2] \cdot a^2 \omega^2/c^2\}. \quad (32)$$

Мощность, поглощаемая на единицу длины плазменным шнуром, связана с переменным магнитным полем, амплитуда которого H_0 постоянна на бесконечности, формулой

$$Q = a^2 \omega |H_0|^2 \operatorname{Im} \gamma/2. \quad (33)$$

Уравнение (28) имеет решение

$$F_{\varphi}(q) = (g(\omega)n^{-2})^{q/n} \Gamma\left(\frac{1-q}{n}\right) \Gamma\left(-\frac{1+q}{n}\right) \varphi(q/n), \quad (34)$$

где $\varphi(x)$ — решение уравнения $\varphi(x+1) = S_{\varphi}(nx)\varphi(x)$.

Отсюда параметр γ выражается в виде [9]:

$$\gamma = \left(\frac{g(\omega)}{n^2}\right)^{2/n} \Gamma\left(-\frac{2}{n}\right) \Gamma^{-1}\left(\frac{2}{n}\right) \exp \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \frac{\ln S_{\varphi}(i\omega n - n/2) \sin 2\pi/n}{\operatorname{ch} 2\pi\omega + \cos 2\pi/n}. \quad (35)$$

В формуле (35) показатель экспоненты, как это следует из (29), является действительным числом. С учетом этого получаем выражение для мнимой части коэффициента γ :

$$\operatorname{Im} \gamma = -\frac{n}{2} \frac{\Gamma(1-2/n)}{\Gamma(2/n)} \left(\frac{|g(\omega)|^2}{n^2}\right)^{2/n} \sin \frac{2 \operatorname{arg} g(\omega)}{n} \times \\ \times \exp \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \frac{\ln S_{\varphi}(i\omega n - n/2) \sin 2\pi/n}{\operatorname{ch} 2\pi\omega + \cos 2\pi/n}. \quad (36)$$

Из выражения (35) следует, что при приближении K к 4 поглощаемая мощность в плазме растет до бесконечности, что связано с тем, что пренебрегать током вне плазмы по сравнению со вторым членом асимптотики (31) можно лишь при $K > 4$, поскольку разные члены в (31) различаются на два порядка (в случае волны электрического типа различие было логарифмическим). В случае $K=4$, в некотором смысле предельном, в решении (34) сливаются два полюса, приводящие к асимптотике логарифмического типа, которая дает логарифмическую расходимость и в γ . Обрезая логарифм на значениях $a\omega/c$, можно изучить и случай $K=4$.

В случае больших значений $K \gg 1$ можно записать следующее выражение для $\operatorname{Im} \gamma$:

$$\operatorname{Im} \gamma = 2n^{-1} \operatorname{arctg} v_{\text{эф}}/\omega.$$

В этом предельном случае окончательное выражение для величины поглощения волны также не зависит от $\varphi(q)$. Подставляя его в форму-

лы (32), (33), получим выражение электродинамических характеристик плазмы через параметры задачи.

В случае волны магнитного типа справедливы те же замечания о глубине проникновения электромагнитной волны в плазму и о применимости теории сильного скин-эффекта, что и в случае волны электрического типа. Глубина проникновения оказывается такой же в случае $K \gg 1$, однако она растет до бесконечности не при $K \rightarrow 2$, а при $K \rightarrow 4$.

Аналогичное исследование взаимодействия волн с плазмой можно провести и для нескомпенсированных электронных пучков [11], в которых электронная концентрация спадает на периферии именно степенным образом. Незначительным отличием от проведенного исследования будет учет направленного движения электронов пучка, что приводит к возможности бесстолкновительного поглощения бегущих вдоль пучка волн, а также их бесстолкновительного усиления при выполнении соответствующих условий. Однако при учете того, что взаимодействие волны с пучком локализовано в основном на периферии пучка, инкременты усиления волн оказываются небольшими.

Автор благодарит акад. И. М. Лифшица и Б. Э. Мейеровича за плодотворные обсуждения работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дикман С. М. «Физика плазмы», 1976, 2, 555.
2. Storer R. G. „Phys. Fluids“, 1973, 16, 949.
3. Blevin H. A., Greene J. M., Storer R. G., Jolly D. L. „J. Plasma Physics“, 1973, 10, 337.
4. Вайнштейн Л. А. Электромагнитные волны. М., 1957.
5. Альперт Я. Л., Гуревич А. В., Питаевский Л. П. Искусственные спутники в разреженной плазме. М., 1964, § 33.
6. Либерман М. А., Мейерович Б. Э., Питаевский Л. П. ЖЭТФ, 1972, 62, 1737.
7. Дикман С. М., Мейерович Б. Э. ЖЭТФ, 1973, 64, 1653.
8. Мейерович Б. Э. ЖЭТФ, 1976, 71, 1045.
9. Васильев А. Н., Мейерович Б. Э. ЖЭТФ, 1974, 67, 1738.
10. Васильев А. Н. ЖЭТФ, 1976, 71, 2113.
11. Мейерович Б. Э., Сухоруков С. Т. ЖЭТФ, 1975, 68, 1783.

Кафедра
квантовой теории

Поступила в редакцию
01.07.77